

2016 年

- 2016-J1(W) 【招待講演】
微細化に依らない MOS トランジスタの性能向上へのアプローチ
SPring-8 利用推進協議会次世代先端デバイス研究会(第 3 回), 日本化学会, 化学会館,
2016 年 3 月 18 日
諏訪智之
- 2016-J2(C) 窒素添加 LaB6 界面層による p 型ペンタセン OFET の界面制御
第 63 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集, (公益社団法人応用物理学会),
20a-W242-6, 2016 年 3 月
前田 康貴, 大見 俊一郎, 後藤 哲也, 大見 忠弘
- 2016-J3(M) マイクロレンズ局所レーザーアニールによる薄膜トランジスタの試作
レーザー研究, Vol.44, No.3, (一般社団法人レーザー学会), pp.193-197, 2016 年 3 月
杉本 重人, 瀬名波 匡, 滝本 政美, 畑中 誠, 水村 通伸, 梶山 康一, 今泉文伸,
後藤 哲也, 城戸 淳二
- 2016-J4(C) 永久磁石を用いたミラー磁場閉じ込め ECR プラズマ源
第 77 回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集, (公益社団法人応用物理学会),
15a-B7-9, 2016 年 9 月
後藤 哲也, 佐藤 恵一郎, 藪田 勇氣, 須川 成利
- 2016-J5(W) 高濃度ドーピングされた(100)方位 SOI ウェーハに対する Si 選択エピタキシャル成長後の平坦
な表面形成技術
電子情報通信学会技術研究報告, Vol.116, No.270, シリコン材料・デバイス
(一般社団法人電子情報通信学会), SDM2016-70(2016-10), pp.9-14, 2016 年 10 月
古川 貴一, 寺本 章伸, 黒田 理人, 諏訪 智之, 橋本 圭市, 須川 成利, 鈴木 大介,
千葉 洋一郎, 石井 勝利, 清水 亮, 長谷部 一秀
- 2016-J6(W) 原子層堆積法で成膜した Al₂O₃ 膜界面に及ぼす酸化種の影響
電子情報通信学会技術研究報告, Vol.116, No.270, シリコン材料・デバイス(一般社団法人電
子情報通信学会), SDM2016-73(2016-10), pp.27-30, 2016 年 10 月
齋藤 雅也, 諏訪 智之, 寺本 章伸, 黒田 理人, 幸田 安真, 杉田 久哉, 林 真里恵,
土本 淳一, 石井 秀和, 志波 良信, 白井 泰雪, 須川 成利
- 2016-J7(W) 動作電圧変化時の過渡状態におけるランダムテレグラフノイズの挙動に関する研究
電子情報通信学会技術研究報告, Vol.116, No.270, シリコン材料・デバイス(一般社団法人電
子情報通信学会), SDM2016-75(2016-10), pp.35-38, 2016 年 10 月
間脇 武蔵, 寺本 章伸, 黒田 理人, 市野 真也, 後藤 哲也, 諏訪 智之, 須川 成利
- 2016-J8(W) 最先端プラズマ装置の研究開発
第 28 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング, pp.31-34, 2016 年 11 月
平山 昌樹
- 2016-J9(W) CMOS イメージセンサの極限性能の追究
第 28 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング, pp.35-42, 2016 年 11 月
須川 成利